



用于AlN单晶生长的复合籽晶及其制备方法

专利名称: 用于AlN单晶生长的复合籽晶及其制备方法
专利类别: 发明
申请号: 201910227102X
第一发明人: 郭丽伟
其它发明人: 胡伟杰;王文军;陈小龙
专利授权日期: 2021-06-15

[关闭窗口](#)

